

К. р. характеризуется трёхмерно-периодич. пространственной системой T точек (рис.), лежащих на концах векторов a_1, a_2, a_3 , при этом трансляции

$$t_{p_1 p_2 p_3} = p_1 a_1 + p_2 a_2 + p_3 a_3, \quad p_i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (1)$$

и если описывать каждую точку δ -функцией, равной 1 в точке и 0 вне её, то К. р. может быть записана как

$$T(\mathbf{r}) = \sum \delta(\mathbf{r} - t_{p_1 p_2 p_3}). \quad (2)$$

Расположение всех частиц, составляющих К. р., описывается т. н. фёдоровскими пространственными группами симметрии кристаллов G_3^3 , каждая из к-рых содержит подгруппу трёхмерных трансляций $T_3 \subset G_3^3$. По симметрии К. р. и центрированности граней элементарной ячейки различают 14 типов К. р.—типов Браве решёток.

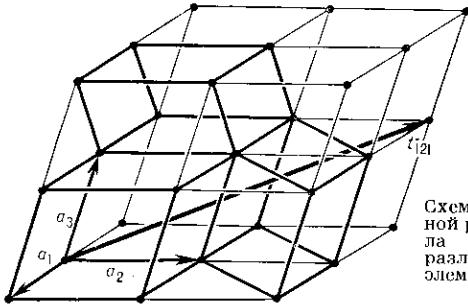


Схема пространственной решётки кристалла и возможность различного выбора элементарной ячейки.

Строго говоря, термин «К. р.» совпадает с термином *пространственная решётка* и означает трёхмерную периодичность, присущую атомному строению кристаллов. В более широком смысле термин «К. р.» употребляется для описания структуры кристаллов вообще. Конкретное расположение атомов в кристаллах наз. *кристаллической структурой* (хотя часто для этого используют термин «К. р.», напр. «К. р. NaCl» или «К. р. шафталина» и т. п.). Если расположение атомов (электронную плотность) внутри одной элементарной ячейки кристалла задать ф-цией $\rho_{\text{яч}}(\mathbf{r})$, то бесконечная трёхмерная кристаллич. структура $\rho_{\text{кр}}(\mathbf{r})$ запишется так:

$$\rho_{\text{кр}}(\mathbf{r}) = \rho_{\text{яч}}(\mathbf{r}) * T(\mathbf{r}), \quad (3)$$

* — знак свёртки, «размножения» одной элементарной ячейки $\rho_{\text{яч}}$ около каждой точки К. р. $T(\mathbf{r})$. Структура реального кристалла отличается от идеализиров. схемы, описываемой понятием «К. р.», тем, что всегда имеются разл. рода дефекты, нарушающие идеальную периодичность,— примесные атомы, вакансии, дислокации и т. д.; их необходимо учитывать, т. к. многие физ. свойства существенно зависят от этих несовершенств.

Б. К. Вайнштейн.

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА — расположение атомов, ионов, молекул в кристалле. Кристалл с определ. хим. ф-лой имеет присущую ему К. с., обладающую трёхмерной периодичностью — *кристаллической решёткой*. Термин «К. с.» употребляют вместо термина «кристаллич. решётка», когда речь идёт об энергии решётки, динамике решётки, о решётке как конкретной структуре того или иного хим. соединения, об описании атомного строения конкретных соединений и их модификаций. Геом. описание конкретной К. с. состоит в указании координат центров атомов в элементарной ячейке кристалла, что позволяет определять межатомные расстояния и тем самым изучать геом. особенностей К. с.

Оси методами исследования К. с. являются дифракционные — *рентгеновский структурный анализ, нейтронография, электронография*. Дифракционные методы дают непрерывное, усреднённое по времени и по всему объёму кристалла распределение рассеивающей мате-

рии в элементарной ячейке К. с. Методами рентг. анализа получают распределение электронной плотности ρ в кристалле, к-рос рассчитывается как ряд Фурье:

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega} \sum_{hkl} F_{hkl} \exp[-2\pi i (hx + ky + lz)], \quad (1)$$

где x, y, z — координаты в элементарной ячейке, Ω — её объём, F_{hkl} — кооф. Фурье, наз. структурными амплитудами. Распределение электронной плотности ρ_0 в ячейке можно приблизённо представить как сумму электронных плотностей атомов $\rho_{\text{ат}}(\mathbf{r}_i)$:

$$\rho_0(\mathbf{r}) = \sum_i^h \rho_{\text{ат}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i), \quad (2)$$

где $\rho_{\text{ат}}(\mathbf{r})$ — усреднённые во времени, т. е. размазанные тепловым движением, распределения электронов в атоме. Максимумы (1) соответствуют атомам — сгусткам электронной плотности, что позволяет найти координаты их центров $\mathbf{r}_i(x_i, y_i, z_i)$ и создать геом. модель, установив межатомные расстояния с точностью до 0,0001—0,00001 нм.

В нейтронографии аналогично (1) по амплитудам ядерного рассеяния кристалла $F_{\text{нейтр}}$ определяют распределение ядерной плотности $n(\mathbf{r})$ ячейки, т. е. вероятностное, размазанное тепловым движением распределение ядер (см. *Нейтронография структурная*). При наличии у атомовмагн. момента нейтронографически определяютмагн. К. с.—распределение спиновой плотности (см. *Магнитная нейтронография*). В электронографии по амплитудам $F_{\text{эл}}$, согласно (1) определяют распределение электростатич. (суммарного — ядер и электронов) потенциала $\Phi(\mathbf{r})$. Положение максимумов всех трёх распределений совпадает — это и есть среднее во времени положение центров атомов (ядер) в элементарной ячейке.

Геометрическая модель. Для создания геом. модели К. с. необходимо: знание параметров элементарной ячейки (шараллелепипеда повторяемости) структуры — в общем случае длины её рёбер a, b, c и углов α, β, γ ; указание симметрии К. с., т. е. принадлежности её к одной из 230 пространственных групп (см. *Симметрия кристаллов*) и тем самым — типу Браве решётки; указание координат всех химически различных атомов и симметрии их позиций. Для этого достаточно знать координаты атомов в симметрически независимой части ячейки, из к-рых можно с учётом операций пространственной группы вывести положение всех атомов К. с. На этой основе рассчитываются межатомные расстояния, взаимная координация атомов и др. геом. характеристики К. с. Графически К. с. изображают расположением атомов («шариков») в элементарной ячейке (рис. 1, а). Крупными соприкасающимися «шарами» в случае необходимости можно показать контакты атомов в плотноупакованных неорганич. (рис. 1, б) или молекулярных структурах. Для изображения ионных К. с. часто пользуются полиздрами, в вершинах к-рых находятся анионы, в центрах — катионы (рис. 1, в).

Геом. анализ К. с. позволил развить целый ряд обобщений и законов атомной структуры кристаллов — представления об атомных радиусах, о типах хим. связей в кристаллах (ионной, ковалентной, металлической, ван-дер-ваальсовой, водородной), правила плотнейшей упаковки атомов и молекул в К. с., связи К. с. со свойствами кристаллов (см. *Кристаллохимия*). Анализ К. с. и её симметрии служит отправным пунктом расчётов энергетич. спектра, истолкования физ. свойств кристалла (см. *Кристаллофизика*).

Изучено более 100 тыс. К. с. разл. веществ, из них ок. 20 тыс. неорганич. К. с. элементов, разл. соединений, минералов, остальную — большую часть — составляют органич. К. с. Периоды решётки разл. кристаллов составляют от долей до сотен нм (табл.). Рентгеноструктурный анализ К. с. органич. соединений есть наиб. точный и достоверный метод определения прост-